

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-274756
(P2004-274756A)

(43) 公開日 平成16年9月30日(2004.9.30)

(51) Int.Cl. ⁷	F I	テーマコード (参考)
H04R 17/00	H04R 17/00 332Y	4C601
A61B 8/00	A61B 8/00	5D019
// B06B 1/02	B06B 1/02 Z	5D107

審査請求 未請求 請求項の数 10 O L (全 15 頁)

(21) 出願番号 特願2004-61534 (P2004-61534)
 (22) 出願日 平成16年3月5日(2004.3.5)
 (31) 優先権主張番号 10/383,990
 (32) 優先日 平成15年3月6日(2003.3.6)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)

(71) 出願人 390041542
 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
 GENERAL ELECTRIC CO
 MPANY
 アメリカ合衆国、ニューヨーク州、スケネ
 クタデイ、リバーロード、1番
 (74) 代理人 100093908
 弁理士 松本 研一
 (74) 代理人 100105588
 弁理士 小倉 博
 (74) 代理人 100106541
 弁理士 伊藤 信和
 (74) 代理人 100129779
 弁理士 黒川 俊久

最終頁に続く

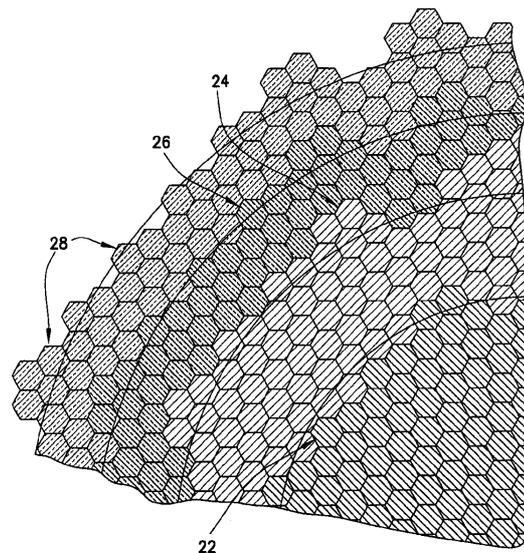
(54) 【発明の名称】 超微細加工超音波トランスデューサを用いたモザイク型アレイ

(57) 【要約】

【課題】 構成可変型アレイを用いた超音波システムの複雑さを抑えて、消費電力及び経費を少なくすると共に可搬性を高める。

【解決手段】 超音波トランスデューサ・アレイが、多数の超小型電子スイッチ(X1、X2、X3)によって相互接続されている多数の小素子(U1、U2、U3)を含んでおり、各々の小素子が多数の超微細加工超音波トランスデューサ(MUT)セル(2)をそれぞれ含んでいる。特定の小素子の内部のMUTセルは互いに結線されている。スイッチを用いて、多数の同心円環状素子を形成するように小素子を構成設定する。この設計は、複雑さを著しく減少させつつ、超音波画像データ取得時の仰角方向の集束を可能にする。

【選択図】 図4



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

多数の小素子（U1、U2、U3）を備えたモザイク型アレイであって、前記小素子の各々が多数の超微細加工超音波トランスデューサ（MUT）セル（2）をそれぞれ含んでおり、各々の超微細加工超音波トランスデューサ・セルが上面電極（12）及び底面電極（10）を含んでおり、任意の特定の小素子を構成する前記超微細加工超音波トランスデューサ・セルの上面電極は互いに結合されており、同じ超微細加工超音波トランスデューサ・セルの底面電極は互いに結合されている、モザイク型アレイ。

【請求項 2】

前記小素子のそれぞれ一つに各々接続されている多数のスイッチ（X1、X2、X3）をさらに含んでいる請求項 1 に記載のモザイク型アレイ。 10

【請求項 3】

半導体基材（4）をさらに含んでおり、前記スイッチは前記半導体基材の内部に作製されており、前記容量型超微細加工超音波トランスデューサ（cMUT）セルは前記半導体基材の上に作製されている、請求項 2 に記載のモザイク型アレイ。

【請求項 4】

前記多数のスイッチを制御するプログラミング回路（66）をさらに含んでいる請求項 2 に記載のモザイク型アレイ。

【請求項 5】

前記プログラミング回路は、オンに切り換えられた小素子が全体的に円環状の環を形成するように前記スイッチを制御する、請求項 4 に記載のモザイク型アレイ。 20

【請求項 6】

多数の超小型電子スイッチにより相互接続されている多数の小素子（U1、U2、U3）を備えた超音波トランスデューサ・アレイであって、各々の小素子が多数の超微細加工超音波トランスデューサ（MUT）セルをそれぞれ含んでおり、特定の小素子内の各々の超微細加工超音波トランスデューサ・セルが互いに結線されている、超音波トランスデューサ・アレイ。

【請求項 7】

それぞれの素子を形成するように選択された小素子を相互接続するプログラミング手段（68）をさらに含んでいる請求項 6 に記載のアレイ。 30

【請求項 8】

前記それぞれの素子は、電子的に形成される円環状アレイの多数の同心円環を形成する、請求項 7 に記載のアレイ。

【請求項 9】

前記小素子は送波時には第一の構成で相互接続され、受波時には前記第一の構成と異なる第二の構成で相互接続される、請求項 7 に記載のアレイ。

【請求項 10】

互いに結線されている上面電極（12）及び互いに結線されている底面電極（10）をそれぞれ含む多数の超微細加工超音波トランスデューサ（MUT）セル（2）と、

前記相互接続されている上面電極又は前記相互接続されている底面電極に接続されている出力端子を有する超小型電子スイッチ（X1）と、 40

該超小型電子スイッチの入力端子に接続されている出力端子を有しており、前記超小型電子スイッチがオンになったときに超音波を発生させるように前記多数の超微細加工超音波トランスデューサ・セルを駆動するドライバ回路（66）とを備えた超音波トランスデューサ。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は一般的には、超音波トランスデューサ素子のモザイク型アレイ、及びアレイにおける超微細加工超音波トランスデューサ（MUT）の利用に関する。MUTの特有的な 50

一応用は医療診断超音波イメージング・システムにある。

【背景技術】

【0002】

従来の超音波イメージング・システムは、超音波ビームを送波し、次いで被検体から反射ビームを受波するのに用いられる超音波トランスデューサのアレイを含んでいる。かかる走査は、集束された超音波を送波し、短時間の後にシステムを受波モードに切り換えて、反射した超音波を受波し、ビームフォーミングして、表示用に処理するという一連の測定を含んでいる。典型的には、送波及び受波は各回の測定中は同一方向に集束されており、音波ビーム又は走査線に沿った一連の点からデータを取得する。受波器は、走査線に沿った一連のレンジ（距離）に動的に集束を行ないながら、反射した超音波を受波する。

10

【0003】

超音波撮像では、アレイは典型的には、1列以上の列を成して配列されており別個の電圧で駆動される多数のトランスデューサを有している。印加電圧の時間遅延（すなわち位相）及び振幅を選択することにより、所与の列の個々のトランスデューサを制御して複数の超音波を発生することができ、これらの超音波を結合して、好ましいベクトル方向に沿って走行しておりビームに沿った選択されたゾーンに集束されている正味の超音波を形成する。

【0004】

トランスデューサ・プローブを用いて受波モードで反射音波を受波するときにも同じ原理が当てはまる。受波を行なうトランスデューサに発生される電圧を、正味の信号が対象内の単一の焦点ゾーンから反射した超音波を示すものとなるように加算する。送波モードの場合と同様に、この集束式超音波エネルギー受波は、受波を行なっている各々のトランスデューサからの信号に対して別個の時間遅延（及び/又は位相シフト）並びにゲインを付与することにより達成される。帰投信号の深さの増大によって時間遅延を調節して、受波時の動的集束を行なう。

20

【0005】

形成される画像の品質又は分解能は部分的には、トランスデューサ・アレイの送波アパーチャ及び受波アパーチャをそれぞれ構成するトランスデューサの数の関数となっている。従って、高画質を達成するためには、二次元撮像応用でも三次元撮像応用でもトランスデューサを多数にすることが望ましい。超音波トランスデューサは典型的には、手掌可搬型トランスデューサ・プローブに配設されており、プローブは可撓性のケーブルによって電子ユニットに接続されており、電子ユニットはトランスデューサ信号を処理して超音波画像を形成する。トランスデューサ・プローブは、超音波送波サーキットリ及び超音波受波サーキットリの両方を担持してよい。

30

【0006】

近年、半導体プロセスを用いて、容量型（CMUT）又は圧電型（PMUT）等の超微細加工超音波トランスデューサ（MUT）として公知の形式の超音波トランスデューサを製造することが行なわれている。MUTは微小なダイヤフラム様の装置であり、超音波受波信号の音響振動を変調型キャパシタンスへ変換する電極を備えている。送波については、容量電荷を変調して装置のダイヤフラムを振動させることにより、音波を送波する。

40

【0007】

MUTの一つの利点は、「超微細加工（マイクロマシニング）」との頭語で括られる超微細製造プロセスのような半導体製造プロセスを用いて製造し得ることである。米国特許第6,359,367号（特許文献1）の説明によれば、次の通りである。

【0008】

「超微細加工は、次の各項の組み合わせ又は部分集合を用いた微視的構造の形成である。すなわち（A）パターンニング・ツール（一般的には投影露光装置又はウェーハ・ステッパ等のリソグラフィ）、（B）PVD（物理的気相堆積）、CVD（化学的気相堆積）、LPCVD（低圧化学的気相堆積）及びPECVD（プラズマ化学的気相堆積）のような堆積ツール、並びに（C）湿式化学エッチング、プラズマ・エッチング、イオン・ミリン

50

グ、スパッタ・エッチング又はレーザ・エッチング等のエッチング・ツール等である。超微細加工は典型的には、シリコン、ガラス、サファイア又はセラミックス製の基材又はウェーハ上で行なわれる。かかる基材又はウェーハは一般的には、極めて平坦且つ滑らかであり、インチ単位の横寸法を有している。これらの基材又はウェーハは通常、カセット内のグループとして、加工ツールから加工ツールへ移動しながら加工される。各々の基材は、製品の多数の複製を組み入れることができ有利である（但し必須ではない）。超微細加工には大きく分けて二つの形式がある。すなわち、(1)バルク超微細加工。この場合にはウェーハ又は基材はその厚みの大部分を蝕刻される、及び(2)表面超微細加工。この場合には蝕刻は一般的には、表面、具体的には表面上の薄膜堆積フィルムに限られる。本書で用いられる超微細加工の定義は、超微細加工が可能な従来の又は公知の材料の利用を含んでおり、かかる材料としては、シリコン、サファイア、あらゆる形式のガラス材料、ポリマー（ポリイミド等）、多結晶シリコン、窒化シリコン、酸窒化シリコン、アルミニウム合金、銅合金及びタングステンのような薄膜金属、スピン・オン・ガラス（S O G）、埋め込み（implantable）ドーパ剤又は拡散ドーパ剤、並びに酸化シリコン及び窒化シリコンのような成長フィルム等がある。」

10

【0009】

本書でも同じ超微細加工の定義を採用する。

【特許文献1】米国特許第6,359,367号

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

20

【0010】

超音波トランスデューサ・アレイの設計を改善することが依然として必要とされている。優れた画質を達成するために、現状の超音波イメージング・システムは非常に複雑とならざるを得ない。従来のプローブは典型的には、128個の信号処理チャンネルを有している（また電子式仰角集束を行なうアレイでは5倍もの増大がある）。また、殆どの撮像モダリティ（超音波を含む）で正しい臨床診断を下すことを可能にするためには、スライス厚を薄くした方が有利である。動的集束ビームを仰角方向及び方位角方向の両方で具現化すると、一般的（心エコーに対して）な撮像応用では特に、極めて複雑で且つ高経費となる。また、電子部品が占める容積及び消費電力は、かかるシステムを易可搬性にするのを阻んでいる。

30

【課題を解決するための手段】

【0011】

本発明は、超音波トランスデューサのアクティブ・アパーチャを、極く小さい小素子（subelement）から成るモザイクとして分割し、次いで、これらの小素子を電子スイッチと相互接続することにより素子を形成するという考案を採用している。これらの素子は、スイッチ構成を変更することにより、モザイク型アレイの表面に沿って電子的に「移動」して走査を実行することができる。他の素子構成は、立体データ集合を取得する能力を提供するビーム方向制御（beam steering）を可能にする。多数の同心円環状素子から成る構成にすると、素子形状が音波の位相面（phase front）に整合することにより最適な音波画像の画質が得られる。本発明の一観点は、得られるアレイの構成可変性（reconfigurability）にある。

40

【0012】

素子を構成変更する能力及び素子を位相面に整合させる能力の両方によって、ハイ・エンド・システムの画質を達成するのに必要な素子（又はチャンネル）の数を大幅に減少させることができる。チャンネル数が少ないので、ビームフォーミング用電子部品によって処理される必要のある信号の数も著しく減少する。従って、モザイク型アレイについてシステム電子部品が占める空間及び消費電力が、可搬性の高い超音波システムと両立するものとなる。

【0013】

本発明の一観点は、多数の小素子を含むモザイク型アレイであって、小素子の各々が多

50

数の超微細加工超音波トランスデューサ(MUT)セルをそれぞれ含んでおり、各々のMUTセルが上面電極及び底面電極を含んでいる。任意の特定の小素子を構成するMUTセルの上面電極は互いに結線されており、これらの同じMUTセルの底面電極も同様に互いに結線されている。

【0014】

本発明のもう一つの観点は、多数の超小型電子スイッチによって相互接続されている多数の小素子を含む超音波トランスデューサ・アレイであって、各々の小素子が多数のMUTセルをそれぞれ含んでおり、特定の小素子内の各々のMUTセルは互いに結線されている。

【0015】

本発明のさらにもう一つの観点は、超音波トランスデューサの製法であって、多数の超小型電子スイッチを内部に有する基材を製造する工程と、基材上に多数のMUTセルを超微細加工する工程とを備えており、各MUTセルはクラスタを成して相互接続されており、相互接続されているMUTセルから成る各々のクラスタは超小型電子スイッチの一つにそれぞれ接続されている。

【0016】

本発明のさらにもう一つの観点は、互いに結線されている上面電極及び互いに結線されている底面電極をそれぞれ含む多数のMUTセルと、相互接続されている上面電極又は相互接続されている底面電極に接続されている出力端子を有する超小型電子スイッチと、超小型電子スイッチの入力端子に接続されている出力端子を有しており、超小型電子スイッチがオンになったときに超音波を発生させるように多数のMUTセルを駆動するドライバ回路とを備えた超音波トランスデューサである。

【0017】

本発明の他の観点については、以下に開示すると共に特許請求の範囲で請求する。

【発明を実施するための最良の形態】

【0018】

以下、図面を参照して説明する。図面では異なる図面で類似の要素に同じ参照番号を付す。

【0019】

本書に開示する新規技術は、超微細加工超音波トランスデューサ(MUT)によってモザイク型アレイを具現化する独自の方法である。説明の目的で容量型超微細加工超音波トランスデューサ(cMUT)を用いた本発明の様々な実施形態を説明する。但し、本書に開示する本発明の各観点は、cMUTの利用に限らず、pMUT、又は下層の切換層への相互接続手段によってダイス加工型小素子の各々が接続されているようなダイス加工型圧電セラミックス・アレイにも適用され得ることを理解されたい。

【0020】

cMUTは、超音波エネルギーの送受が可能な小型(例えば、50 μ m)の容量型「ドラムヘッド」又はセルを含むシリコン系装置である。図1には、典型的なMUTトランスデューサ・セル2の断面図が示されている。かかるMUTトランスデューサ・セルから成るアレイが典型的にはシリコン・ウェーハのような基材4上に製造される。各々のMUTトランスデューサ・セル毎に、基材4の上方に、窒化シリコン製の薄膜又はダイヤフラム8が懸吊されている。膜8は、酸化シリコン又は窒化シリコン製の絶縁性支持体6によって周縁で支持されている。膜8と基材4との間の空洞部20は、空気若しくはガスを充填されていてもよいし、又は完全排気若しくは部分排気されていてもよい。アルミニウム合金又はその他適当な導電性材料のような導電性材料のフィルム又は層が膜8上で電極12を形成しており、また導電性材料製のもう一つのフィルム又は層が基材4上で電極10を形成している。代替的には、電極10は基材4に埋め込まれていてもよい。また、電極12は図1に示すように膜8の内部に埋め込まれているのではなく、膜8の表層に位置していてもよい。

【0021】

10

20

30

40

50

2 個の電極 10 及び 12 は、空洞部 20 によって離隔されて、キャパシタンスを形成する。入射した音響信号が膜 8 を振動させると、付設の電子部品（図 1 には示されていない）を用いてキャパシタンスの変化を検出することができ、これにより音響信号を電気信号へ変換する。逆に、一方の電極に印加された AC 信号が電極上の電荷を変調させると、電極同士の間容量力に変調が生じ、後者の変調によってダイヤフラムが移動することにより音響信号を送波する。

【0022】

動作について述べると、MUTセルは典型的には、電極に跨がって印加される時間変化型の電圧 $v(t)$ よりも有意に高い DC バイアス電圧 V_{bias} を有している。バイアスはクーロン力によって上面電極を底面に向かって引き付ける。大きいバイアスを印加するこの例では、MUTのドラムヘッドは、次の式のように与えられる膜変位 u を生ずる。

10

【0023】

【数 1】

$$u(t) \approx \frac{\epsilon}{d^2} * V_{bias} * v(t) \quad (1)$$

【0024】

式中、 d は各電極すなわちキャパシタの各プレートの間の距離であり、 ϵ はセルの実効誘電率である。MUTセルの感度は、バイアス電圧が高く且つ各電極が相対的に近接している場合に最大となることが分かっている。

20

【0025】

典型的なMUTの寸法はミクロン単位であるので、多数のMUTセルが典型的には近接して製造されて、単一のトランスデューサ素子を形成する。個々のセルは、円形、矩形、六角形又は他の周囲形状を有してよい。六角形にするとトランスデューサ素子のMUTセルを稠密に充填することができる。各MUTセルは、トランスデューサ素子が異なるセル寸法による複合的な特性を有することによりトランスデューサに広帯域特性を与えるように、異なる寸法を有してよい。

【0026】

MUTセルは、超微細加工プロセスにおいて互いに結線されて、小素子すなわち何らかの高度と考えられる態様でグループ化された個々のMUTセルから成るクラスタを形成することができる。（「小素子」という用語は、以下ではかかるクラスタを記述するために用いられる）。これらの小素子は、MUT小素子を構築する基材となるシリコン層の内部に超小型電子スイッチを配置することにより、かかる超小型電子スイッチ（結線ではなく）によって相互接続されて、円環のような相対的に大きい要素を形成する。この構築は、大量の量において低経費で実行され得る半導体プロセスに基づいて行なわれる。

30

【0027】

最良の音響性能を得るモザイクを設計する多くの方法が存在する。例えば、送波時及び受波時の両方での位相面を整合させる、隣接する小素子の間に間隙を設けて素子間クロストークを低減する、モザイク格子のテセレーション（tessellation、領域充填）を形成するように様々な小素子パターンを選択する、並びに送波及び受波について様々な素子パターンを選択する等を行なって、特定応用における最高の音響性能を得ることができる。

40

【0028】

本書に開示する実施形態では、トランスデューサは、ビーム方向、焦点位置、並びに最小のサイドローブ及びグレーティング・ローブ（grating lobe）に関して特定の音響出力を提供するように多くの方法で相互接続することのできるMUT小素子のアレイを用いて製造される。

【0029】

説明の目的で、図 2 は、中央のセルを 6 個のセルの環で包囲した 7 個の六角形 MUT セル 2 で構成される「デージー型」小素子 14 を示しており、環を成す各々のセルは中央セルの各辺と連続しており且つ環を成す隣接セルとも連続している。各々のセルの上面電極

50

は互いに結線されている。同様に、各々のセルの底面電極も互いに結線されており、7倍の大きさの容量型小素子を形成している。

【0030】

代替的な「六角型」小素子16を図3に示しており、この小素子16は19個のMUTセルで構成されている。各々のグループのセルの上面電極は互いに結線されており、同様に、各々のグループのセルの底面電極も接続されており、これによりさらに大きい容量型小素子を形成している。MUTセルは極めて小形に製造され得るので、極微細ピッチのモザイク型アレイを完成することが可能である。

【0031】

本発明の範囲内にあるMUTセル及び小素子を用いてトランスデューサ・アレイを形成し得る方法は多数存在する。図4及び図5は、モザイク型アレイを形成するための小素子のテセレーションの実例を示す。図4に示す実施形態では、「デージー型」小素子（小素子当たり7個のMUTセルが互いに結線されている）のテセレーションを各々含む4個の近似的に円環状の素子（参照番号22、24、26及び28によってそれぞれ示す）が、近似的に等しい素子当たり面積を有するように構成されている。図5に示す実施形態では、「デージー型」小素子のテセレーションを各々含む6個の近似的に円環状の素子（参照番号30、32、34、36、38及び40によってそれぞれ示す）が、近似的に等しい素子当たり面積を有するように構成されている。各々の例でのテセレーションは、多数の小素子形式で構成されていてよい。アレイのパターンはテセレーションである必要はなく、音響小素子の存在しない区域を有していてもよい。例えば、MUT小素子又はセルの上面電極接続をアレイの下方に誘導するバイアが存在していてもよい。

10

20

【0032】

本発明の構成を、ビーム幅、サイドローブ・レベル又は焦点深さのような様々な音響パラメータを最適化するように変更してもよい。代替的には、小素子を送波動作について一つのアパーチャを形成するようにグループ化し、受波部分については他のアパーチャに直ちに切り換えてもよい。図4及び図5は近似的に円環状の素子を示しているが、例えば不連続環、八角環（octal ring）又は円弧等のような他の構成を具現化してもよい。パターンの選択は応用からの要求に応じたものとなる。

【0033】

図6及び図7は、「六角型」小素子のテセレーションを含む素子パターンの幾つかの実例を示す。図6に示す実施形態は、「六角型」小素子（小素子当たり19個のMUTセルが互いに結線されている）のテセレーションを各々含む4個の素子（参照番号42、44、46及び48によってそれぞれ示す）を有している。素子は円形ではない。具体的には、第三の素子は不連続環となっており、又はさらに正確に述べると、複数の「六角型」小素子が等角度間隔で円周に分配されている。図7に示す実施形態は、「六角型」小素子のテセレーションから各々成る6個の素子（参照番号50、52、54、56、58及び60によってそれぞれ示す）を有している。本実施形態では、第四の素子は不連続環となっており、第一の素子（すなわち中央素子）は円形ではなく六角形となっている。

30

【0034】

尚、図4～図7に示す各パターンは説明のみを目的とすることを理解されたい。その他多くのパターンを画定することができ、この開示は本新規技術を本書に明示的に示すものに限定する訳ではない。

40

【0035】

モザイク型円環状アレイの場合には、これらの円環によって、ビームフォーミング用電子部品によって処理されねばならない信号の数を大幅に減少させることが可能になる。例えば、cMUTセルが8素子の円環状アレイに分配されているとすると、ビームフォーミング用電子部品はこれらの円環によって出力される8つの信号のみを扱えばよいことを意味する。このことは、従来のプローブの場合には信号処理チャンネルの数が典型的には128個（また電子式仰角集束を行なうアレイではこの数の5倍になる）であることと全く対照的である。

50

【0036】

本発明のさらにもう一つの観点では、構成可変型アレイでの素子間のクロストークを、小素子の間に小さな間隙を導入することにより低減することができる。図8は、「デージー型」小素子14のテセレーションを示しており、同図では各々の「デージー型」小素子が間隙62によって隣接する小素子から離隔されている。図9は、「六角型」小素子16のテセレーションを示しており、同図では各々の「六角型」小素子が間隙64によって隣接する小素子から離隔されている。クロストークをさらに低減するためには、各々の小素子の周りのシリコン基材に溝を具現化することができる。

【0037】

各小素子（「デージー型」、「六角型」又は他の形状）は、アレイの下方のスイッチを用いて動的に接続することができ、任意の素子パターンの形成を可能にし、すなわち換言すると構成可変型アレイの形成を可能にする。これらのスイッチは別個にパッケージ化されている構成要素であってよいが、MUTアレイを製造する基材となる同じ半導体基材の内部にスイッチを実際に製造することも可能である。MUTアレイを形成するのに用いられる超微細加工プロセスは、この集積型電子部品には何ら悪影響を及ぼさない。

10

【0038】

本発明の一観点では、パルス発生回路を用いることにより高電圧スイッチの数を減少させることが可能であり、パルス発生回路は、高インピーダンスMUTが必要とする電流が極めて限定されているため小型化することができる。

【0039】

各々のMUT小素子は、二極動作を可能にするように接して接続されている2個のDMOS FET（ソース・ノードが共に短絡されている。図10のスイッチX1～X3を参照）を含む高電圧切換回路によって駆動され得る。かかる切換回路は、米国特許出願10/248,968号“Integrated High-Voltage Switching Circuit for Ultrasound Transducer Array”に開示されている。この切換回路では、両方のFETがオンになっているときには常に、スイッチ端子に電流が流れる。スイッチをオンにするためには、これらの装置のゲート電圧は、ソース電圧よりも閾電圧分だけ高くなければならない。閾電圧を上回ると、スイッチのオン抵抗はゲート電圧に反比例して変化する。ソース電圧がドレイン電圧に近くなるので（オン抵抗が小さく電流が小さいため）、ソース電圧は超音波送波パルス電圧に追従する。ゲート・ソース電圧を一定にしておくために、ゲート電圧もまた送波パルス電圧に追従しなければならない。このことは、スイッチ制御サーキットリからソース及びゲートを切り離して、ソースを参照としてゲートでの電位を固定することにより達成することができる。このことは好ましくは、ダイナミック・レベル・シフトを用いて達成される。

20

30

【0040】

上述の米国特許出願10/248,968号は、ダイオードを介してDMOS FETの共通ゲートにドレインを接続した高電圧PMOSトランジスタを含むオン切換回路を開示している。PMOSトランジスタのゲートは、スイッチのゲート・オン切換電圧VPを受け取る。PMOSトランジスタのソースはグローバル・スイッチ・ゲート・バイアス電圧（ノミナルで5V）にバイアスされている。スイッチをオンに切り換えるために、PMOSトランジスタのゲート電圧VPは高電圧（5V）から低電圧（0V）へ移行し、PMOSトランジスタを介してDMOS FETの共有ゲート端子へグローバル・バイアス電圧を印加する。スイッチ・ゲート電圧VPがグローバル・スイッチ・ゲート・バイアス電圧を上回ってドリフトしたときにPMOSトランジスタがオンにならないようにするためにダイオードを設けている。一旦、スイッチ・ゲート電圧VPがスイッチ・ゲート・バイアス電圧に到達したら、DMOS FETの寄生ゲート・キャパシタンスはこの電圧を保持する。この理由から、一旦、ゲート電圧VPが安定したら、PMOSトランジスタをオフにして節電することができる。スイッチのオン状態がスイッチ・ゲート・キャパシタンスに実効的に記憶されるという事実は、スイッチがスイッチ自体のメモリを有していることを意味する。

40

50

【 0 0 4 1 】

図 10 (上で参照した米国特許出願 10 / 2 4 8 , 9 6 8 号から引用) に示すように、この切換回路をスイッチの縦続接続の一部として用いることができる。図 10 に示す縦続接続の例は直列接続されている 3 個のスイッチ X 1、X 2 及び X 3 を含んでいるが、図示の態様で 3 個よりも多いスイッチを縦続接続してよいことを理解されたい。スイッチ X 1 ~ X 3 の状態は、それぞれのスイッチ制御回路 C 1 ~ C 3 によって制御される。ゲート・オフ切換電圧 V N 及びゲート・オン切換電圧 V P を制御するデジタル回路 (図示されていない) が存在している。このデジタル回路は、スイッチの状態に関するローカル・メモリを有している。外部の制御システム (図 10 のプログラミング回路 6 8) が、スイッチ・メモリの全てがオン、オフ又は N O _ C H A N G E のいずれかの状態になるようにプログラムしている。次いで、グローバル選択線 7 0 (図 10 を参照) を用いてこの状態を実際のスイッチ制御回路に適用する。従って、選択線が起動されるまで、V N 及び V P は両方ともゼロである。この状態で、スイッチ自体は最終の状態を保持している。グローバル選択線 7 0 が起動されると、V N を高にする (スイッチをオフにする) か、V P を低にする (スイッチをオンにする) か、又は V N 及び V P を両方とも低にする (スイッチ状態を変化させない) のいずれかにより、記憶されているスイッチ状態をスイッチ自体に伝達する。図 10 の各々のスイッチ X 1 ~ X 3 のグローバル・スイッチ・ゲート・バイアス電圧端子はバス 7 2 に接続されている。グローバル選択線 7 0 をグローバル・スイッチ・ゲート・バイアス電圧バス 7 2 と組み合わせると、各々のスイッチ X 1 ~ X 3 のオン切換電圧を独立にプログラムすることが可能になる。さらに明確に述べると、各々のスイッチは

10

20

【 0 0 4 2 】

さらに図 10 の説明を続ける。スイッチ X 1 がオンになったときには超音波ドライバ 6 6 によって第一の超音波トランスデューサ U 1 を駆動することができ、スイッチ X 1 及び X 2 が共にオンになったときには超音波ドライバ 1 0 によって第二の超音波トランスデューサ U 2 を駆動することができ、スイッチ X 1、X 2 及び X 3 が全てオンになったときには超音波ドライバ 1 0 によって第三の超音波トランスデューサ U 3 を駆動することができる。各々の超音波トランスデューサは、本書に開示した各形式の一つの小素子であってよい。

30

【 0 0 4 3 】

(実施例 1)

(構成可変型 M U T によるモザイク型アレイの応用)

本発明は、アレイの構成可変性の概念を活用している。以下の実施例は、活用できる可能性の集合全体を網羅するためではなく、説明の目的のために掲げられるものとする。

【 0 0 4 4 】

a . 円環状アレイ

公知の非モザイク型円環状アレイでは、中央素子及び各円環が全て等しい面積を有しているという等面積近似を用いてアレイを構築することが一般に行なわれている。このアプローチでは、各々の素子間での位相シフトは強制的に一定とされる。また、全ての素子インピーダンスを一様であるものとし、これにより、素子を駆動したり素子から受波したりするサーキットりに等しい負荷を与えている。このことを助けとして各々の素子のスペクトル内容が近似的に一様になり、従って、送波及び受波時のビームフォーミング過程の一貫性が最大限になる。

40

【 0 0 4 5 】

しかしながら、コンピュータ・シミュレーションによれば、等面積アプローチでは、近距離音場に与かる素子の数が限定されるため、アレイの近距離音場性能が限定される。代替的な一設計は、定数 F 数設計と呼ばれ、平坦な (予め集束されていない) 円環状アレイに関するものである。このアプローチでは、アパーチャから外れない限り関心のあるレン

50

ジ全体にわたって一定のF数を保とうとする。これらの設計及び他の変形設計は、本書に開示したMUT小素子の構成可変型アレイによって容易に具現化される。

【0046】

b. 非円環状アレイ

MUTの構成可変性によって、モザイク型アレイ素子の形状及び寸法に際立った一般性が可能になることが理解されよう。臨床応用によっては、楕円設計（仰角撮像を用いる場合）又は可能性としては疎分散アレイ設計のような他の構成を必要とする場合もある。

【0047】

c. 送波対受波での異なる構成

MUTアレイ基材の内部の集積型電子部品は、アレイ素子のパターン又は構成を迅速に切り換える能力を提供する。このことが音響性能に齎す一つの利点は、受波アパーチャとは異なる送波アパーチャを用いる能力である。送波時には、固定された焦点深さに最適なアパーチャを構成することができ、受波時には動的に変化する焦点（又はアパーチャ若しくはアボダイゼーション）に適したアパーチャを具現化することができる。本実施例は、アパーチャの寸法の変更に限定されない（例えば、全てのシステム・チャンネルを送波及び受波の両方に用いることができる）。

【0048】

d. ビーム方向制御

構成可変型アレイは、所与のビームについて同様の遅延値を有する小素子を共にグループ化することによりビームを方向制御する可能性を齎す。側面方向（broadside）のビームは円環様に成形されたグループを形成する一方、垂線から離隔するように方向制御されるビームは円弧形状のグループを形成する。

【0049】

ビームを三次元で方向制御することもでき、すなわち方位角方向及び仰角方向の両方に方向制御することができる。構成可変型設計による付加価値は、典型的なフェーズド・アレイは浅い方向制御角での音場を著しくオーバサンプリングしているため、より少数のシステム・チャンネルでこれらの方向制御されたビームを実現し得るということである。このように、所要の時間遅延に従ってモザイク設計において素子を共に実効的にグループ化することにより、限定された数のチャンネルでビーム方向制御を達成することができる。所要の離散的な遅延の数は、空間サンプリングの粗さが増すにつれて生ずるサイドローブのレベルに関係する。

【0050】

（実施例2）

（音響性能の向上）

a. 小素子間でのバイアス電圧のばらつき

送波アパーチャでの急激な振幅変化からギブス現象に関連する過程を介して相対的に大振幅のサイドローブが発生することは周知である。一次元アレイの場合には、殆どの製造者はこれらのサイドローブを減少させるように加重（又はアボダイゼーション）を適用している。アレイの表面に対して垂直な方向に送波するモザイク型円環状アレイの場合には、アボダイゼーションをアレイの個々の環に対して適用することができる。ビーム方向制御を行なうモザイク型円環状アレイでは、円弧の各々に一定の振幅を適用しなければならず、これらの円弧はモザイク型円環状アレイのアパーチャの辺縁で終端しているため、上述のアボダイゼーションは最早可能でない。この問題点を解決するために、アパーチャに跨がるバイアス電圧を修正して、MUTセルの全体にわたって球面型（又は他の形状の）変調を生成し、これによりビーム形成過程を所望に応じて変化させることができる。一般的には、このことは、アクティブ・アパーチャにわたってバイアス電圧を制御することを意味する。この場合にもやはり、この制御の離散性は、所望のビーム品質及び許容され得る回路の複雑さによって決定される。バイアス電圧を用いてアボダイゼーションの形態を確定することにより、円環を用いている場合でも、アボダイゼーション関数の形状は円環ではなく小素子によって決まるので、アボダイゼーションはさらに制御し易くなる。

10

20

30

40

50

【0051】

さらに、プロセスばらつきのため小素子の音響感度はアレイ全体で一様でなくなる可能性がある。感度はバイアス電圧に依存するので、各々の小素子のこの電圧を独立に調節することにより感度のばらつきを補償することができる。

【0052】

b. 適応型音響応用

ビームフォーミングの品質は、アレイ内の任意の小素子（又は複数の小素子から成る任意のグループ）によって受波されるエコーを単離して、モザイク型アレイの全ての素子からの和（ビーム和）のエコーに対する上述のエコーの時間的關係を比較することにより定期的に検査することができる。次いで、この小素子（又はグループ）を、ビーム和信号に対する位相關係又は時間遅延關係に応じて異なる円環又は円弧に再度割り当てることのできる。

10

【0053】

c. 高調波応用

本書に開示するモザイク型アレイはまた、広い帯域幅という利点を与える。モザイク型アレイを用いると、特にモザイク型円環構成の場合には、音場に対する可能な制御性が高くなるため、矩形アパーチャで達成可能であるものよりも大量の高調波エネルギーを発生することが期待される。さらに、MUTの帯域幅が広いので、この付加的高調波エネルギーはさらに容易に検出されるものと期待される。

【0054】

広帯域幅性能に関して、第三高調波撮像の可能性は、本書に開示するモザイク型アレイによるアプローチであれば遥かに高まる（現行のシステムは第二高調波のみを用いている）。

20

【0055】

さらに、本書に開示するモザイク型アレイはビーム形状についての利点を与える。組織特徴評価（キャラクタリゼーション）のような手法は、MUTのような広帯域幅素子の利用によって直接的に利得を得る。この理由は、組織特徴が、優れた分解能のためさらに十分にサンプリングされるからである。

【0056】

要約すると、本書に開示する発明は、スライス厚を薄くすること、仰角方向で動的に集束されるビーム、及びアレイの構成可変性を含めた優れたビーム性能を提供して、具体的な診断環境での音響性能を高める。本発明はまた、チャンネル数が減少したことによりシステムの複雑さを抑えて、消費電力及び経費を少なくすると共に可搬性を高めている。

30

【0057】

MUT技術をモザイク型アレイと併用することにより、微小ピッチの素子を構成変更して、多くの異なる超音波応用にわたって優れた画質を与えるのに必要とされる音響位相面に整合させる能力が提供される。MUTセルはまた、非共振構造でもある。結果として、MUTセルは、従来 of 圧電セラミックス・アレイよりも遥かに広い周波数範囲にわたって動作することが可能である。モザイク型アレイ技術によって、実時間二次元撮像及び電子駆動式三次元撮像を既存の最新型アレイよりも遥かに細かいビーム成形及び遥かに細かい制御で行なうことができる。

40

【0058】

好適実施形態を参照して本発明を説明したが、当業者であれば本発明の範囲から逸脱せずに様々な変形を施した各実施形態の要素を均等構成で置換し得ることが理解されよう。加えて、発明の本質的な範囲から逸脱せずに本発明の教示に合わせて具体的な状況を適応構成する多くの改変を施すことができる。従って、本発明は、本発明を実施するのに想到される最良の態様として開示した特定のな実施形態に限定されているのではなく、特許請求の範囲に含まれる全ての実施形態を包含するものとする。

【図面の簡単な説明】

【0059】

50

【図 1】典型的な c M U T セルの断面図である。

【図 2】上面電極及び底面電極がそれぞれ互いに結線されている 7 個の六角形 M U T セルから形成される「デイジー型」小素子を示す図である。

【図 3】上面電極及び底面電極がそれぞれ互いに結線されている 19 個の六角形 M U T セルから形成される「六角型」小素子を示す図である。

【図 4】本発明の一実施形態による 4 個の円環状素子を含むモザイク型アレイの一部を示す図であって、各々の円環状素子が近似的に等しい素子当たり面積を有するように構成されている「デイジー型」小素子のテセレーションから成っている場合の図である。

【図 5】本発明のもう一つの実施形態による 6 個の円環状素子を含むモザイク型アレイの一部を示す図であって、各々の円環状素子が近似的に等しい素子当たり面積を有するように構成されている「デイジー型」小素子のテセレーションから成っている場合の図である。

【図 6】本発明のさらにもう一つの実施形態による 4 個の素子を含むモザイク型アレイの一部を示す図であって、各々の素子が「六角型」小素子のテセレーションから成っている場合の図である。

【図 7】本発明のさらにもう一つの実施形態による 6 個の素子を含むモザイク型アレイの一部を示す図であって、各々の素子が「六角型」小素子のテセレーションから成っている場合の図である。

【図 8】信号クロストークの低減のための間隙によって離隔されている「デイジー型」小素子のテセレーションを示す図である。

【図 9】信号クロストークの低減のための間隙によって離隔されている「六角型」小素子のテセレーションを示す図である。

【図 10】本発明の一実施形態によるモザイク型アレイの超音波トランスデューサを選択的に駆動する高電圧切換回路の縦続接続の図である。

【符号の説明】

【0060】

2 M U T トランスデューサ・セル

4 基材

6 絶縁支持体

8 ダイアフラム

10、12 電極

14 デイジー型小素子

16 六角型小素子

20 空洞部

22、24、26、28 デイジー型小素子による 4 素子型円環状素子

30、32、34、36、38、40 デイジー型小素子による 6 素子型素子

42、44、46、48 六角型小素子による 4 素子型素子

50、52、54、56、58、60 六角型小素子による 6 素子型素子

62、64 素子間間隙

70 グローバル選択線

72 バス

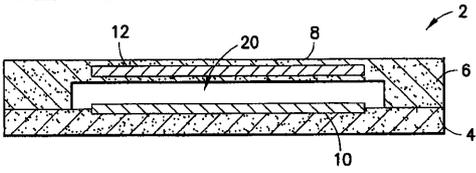
10

20

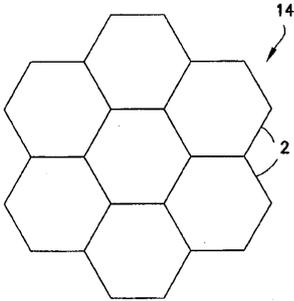
30

40

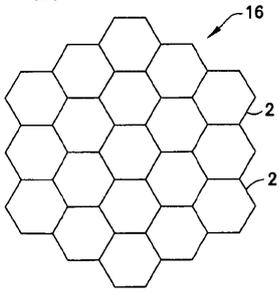
【 図 1 】



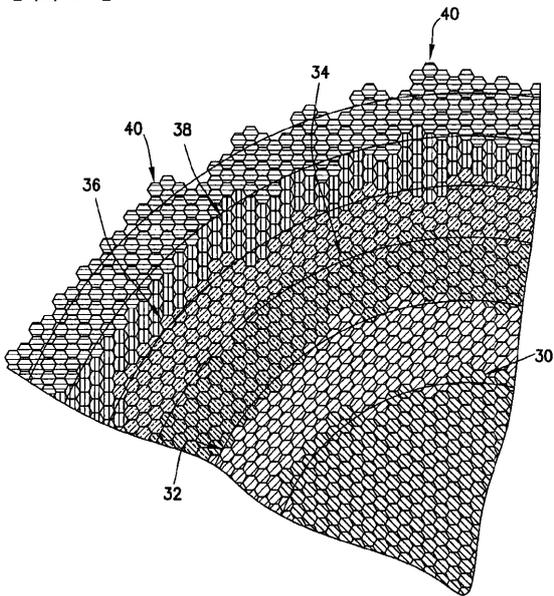
【 図 2 】



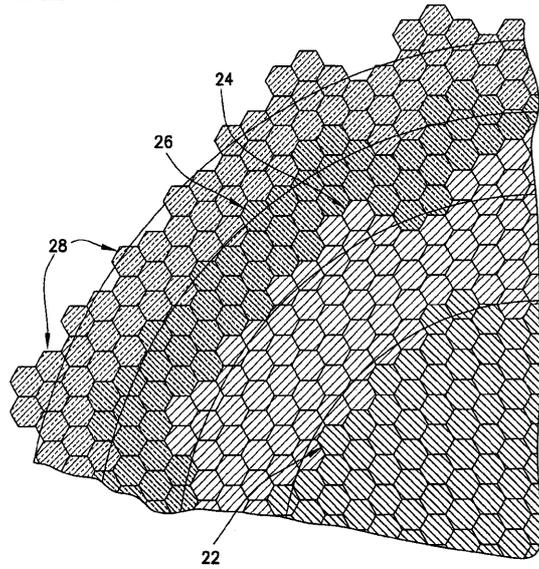
【 図 3 】



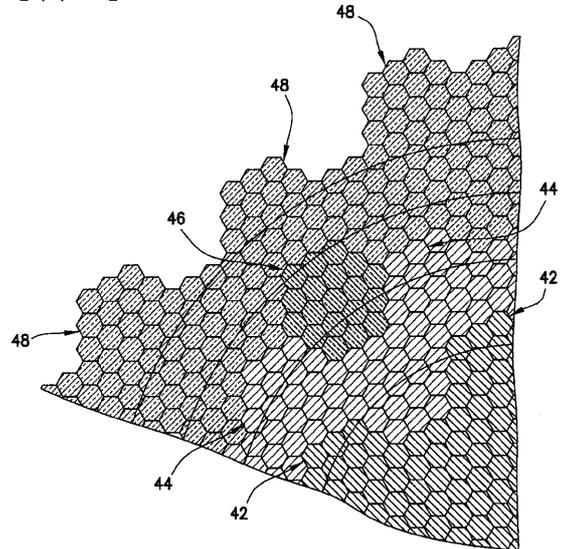
【 図 5 】



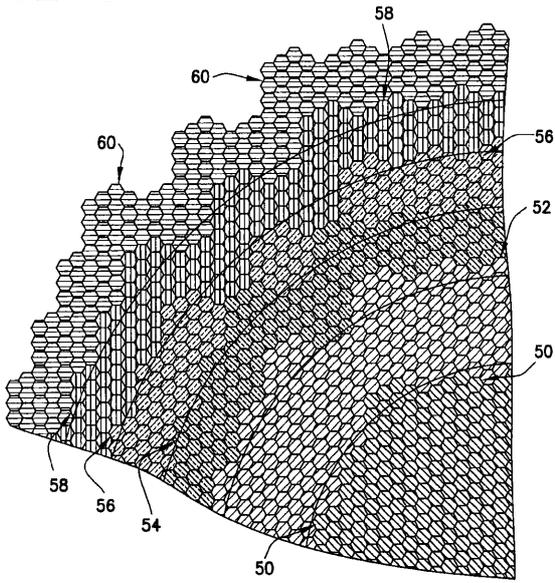
【 図 4 】



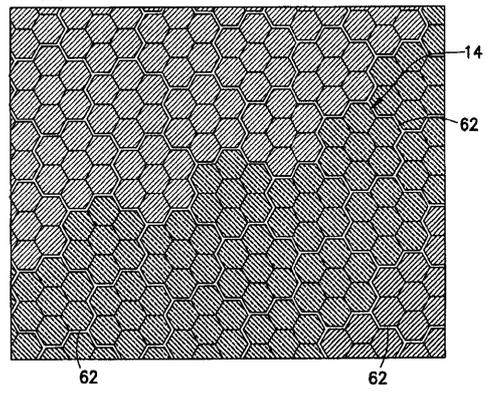
【 図 6 】



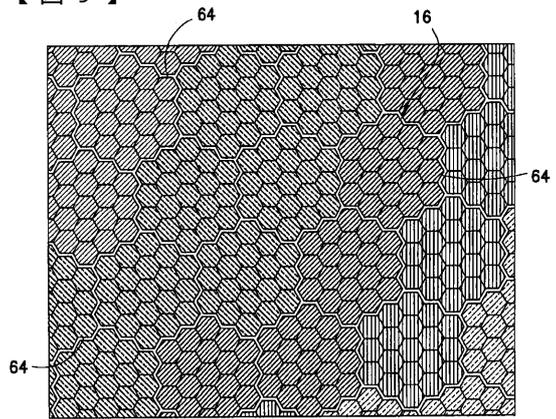
【 図 7 】



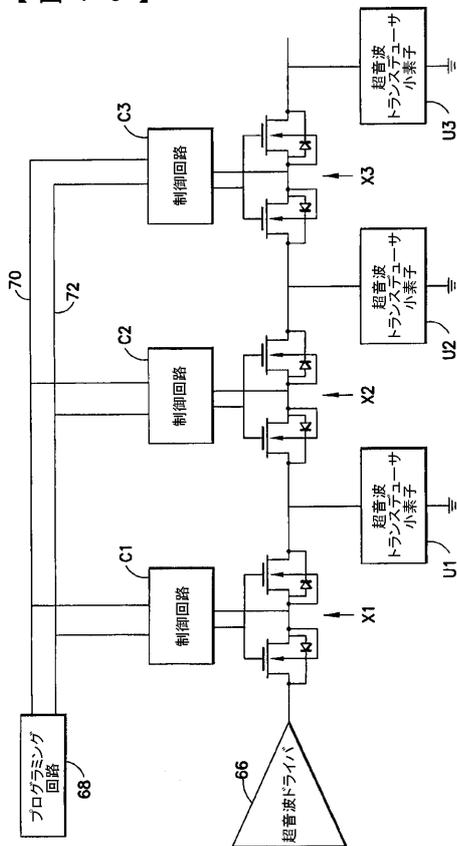
【 図 8 】



【 図 9 】



【 図 10 】



フロントページの続き

- (72)発明者 カイ・トーマニアス
アメリカ合衆国、ニューヨーク州、クリフトン・パーク、ファン・フランケン・ロード、74番
- (72)発明者 レイエット・エー・フィッシャー
アメリカ合衆国、ニューヨーク州、ニスカユナ、パークリー・アベニュー、2305番
- (72)発明者 デビッド・エム・ミルズ
アメリカ合衆国、ニューヨーク州、ニスカユナ、ヘリテッジ・ロード、1915番
- (72)発明者 ロバート・ジー・ウッドニッキー
アメリカ合衆国、ニューヨーク州、ニスカユナ、クーリッジ・プレイス、2031番
- (72)発明者 クリストファー・ロバート・ハザード
アメリカ合衆国、ニューヨーク州、スケネクタデイ、エーピーティアー・ナンバー1、グレンウッド
・ブルヴァール、1033番
- (72)発明者 ロウエル・スコット・スミス
アメリカ合衆国、ニューヨーク州、ニスカユナ、チェシャー・プレイス、24番
- Fターム(参考) 4C601 BB03 EE01 EE04 EE13 EE14 EE15 GB06 GB07 GB12 GB20
GB21 GB41 HH01 HH29
5D019 AA01 BB08 BB20 BB25 FF04 HH01
5D107 AA03 AA04 AA12 BB07 CC05 CC11 CC12 CD08

专利名称(译)	使用超声处理超声换能器的马赛克阵列		
公开(公告)号	JP2004274756A	公开(公告)日	2004-09-30
申请号	JP2004061534	申请日	2004-03-05
[标]申请(专利权)人(译)	通用电气公司		
申请(专利权)人(译)	通用电气公司		
[标]发明人	カイトーメニアス レイエットエーフィッシャー デビッドエムミルズ ロバートジーウッドニッキー クリストファーロバートハザード ロウエルスコットスミス		
发明人	カイ・トメニアス レイエット・エー・フィッシャー デビッド・エム・ミルズ ロバート・ジー・ウッドニッキー クリストファー・ロバート・ハザード ロウエル・スコット・スミス		
IPC分类号	A61B8/00 B06B1/02 B06B1/06 H04R17/00		
CPC分类号	B06B1/0292 E05B77/44 E05B81/60 E05B83/18 E05Y2900/548		
FI分类号	H04R17/00.332.Y A61B8/00 B06B1/02.Z H04R19/00.330		
F-TERM分类号	4C601/BB03 4C601/EE01 4C601/EE04 4C601/EE13 4C601/EE14 4C601/EE15 4C601/GB06 4C601/GB07 4C601/GB12 4C601/GB20 4C601/GB21 4C601/GB41 4C601/HH01 4C601/HH29 5D019/AA01 5D019/BB08 5D019/BB20 5D019/BB25 5D019/FF04 5D019/HH01 5D107/AA03 5D107/AA04 5D107/AA12 5D107/BB07 5D107/CC05 5D107/CC11 5D107/CC12 5D107/CD08 5D019/DD01		
代理人(译)	松本健一 小仓 博 伊藤亲		
优先权	10/383990 2003-03-06 US		
其他公开文献	JP4293309B2 JP2004274756A5		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

为了降低使用可重配置阵列的超声系统的复杂性，降低功耗和成本，并增强便携性。超声换能器阵列包括通过多个微电子开关（X1，X2，X3）互连的多个子元件（U1，U2，U3），每个子元件。每个单元都包含多个微机械超声换能器（MUT）单元（2）。特定子元素内部的MUT单元硬接线在一起。开关用于配置子元件以形成多个同心环形元件。这种设计允许在超声图像数据获取期间进行高度聚焦，同时显著降低复杂度。[选择图]图4

